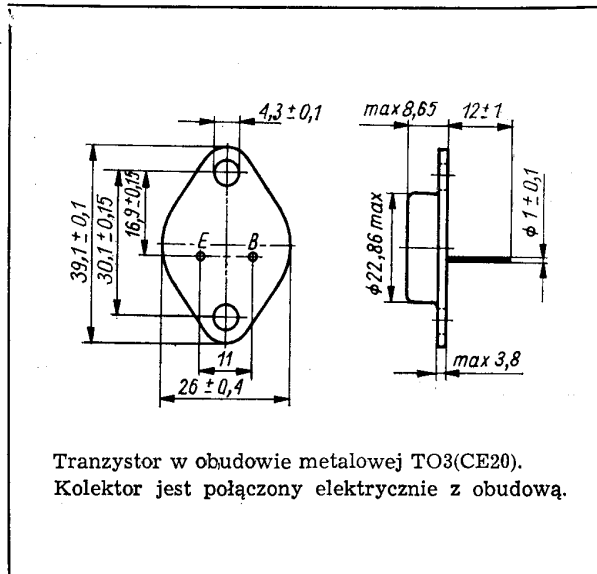


Tranzystory germanowe stopowe dużej mocy małej częstotliwości. Są przeznaczone do stosowania we wzmacniaczach akustycznych i przetwornicach. Do układów przeciwobnych tranzystory są dobierane parami.



**DANE TECHNICZNE**

**Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych**

Typ		ADP670	ADP671	ADP672	
Napięcie kolektor-baza	$-U_{CB0}$	20	30	60	V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CES}$	20	30	60	V
Napięcie emiter-baza	$-U_{EB0}$	10	10	10	V
Prąd kolektora	$-I_C$	1,5	1,5	1,5	A
Prąd szczytowy kolektora	$-I_{CM}$	3	3	3	A
Prąd szczytowy bazy	$-I_{BM}$	0,5	0,5	0,5	A
Prąd emitera	$-I_E$	1,6	1,6	1,6	A
Prąd szczytowy emitera	$-I_{EM}$	3,3	3,3	3,3	A
Temperatura złącza	$t_j$	348 K (75°C)			
Zakres temperatury składowania	$t_{etg}$	248...328 K (-25...+55°C)			
Moc strat kolektora przy $t_{case} = 298$ K (25°C)	$P_C$	10	10	10	W

**SWW 1156-231**

**Parametry termiczne**

Rezystancja termiczna					
złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	33	33	33	K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	5	5	5	K/W

**TRANZYSTOR ADP670**

**Parametry statyczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (+25°C)		min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmocnienia prądowego					
przy $-I_C = 0,3$ A, $-U_{CE} = 6$ V	$h_{21E}$	30	—	200	—
przy $-I_C = 3$ A, $-U_{CE} = 1$ V	$h_{21E}$	10	—	—	—
Prąd zerowy kolektora					
przy $-U_{CB} = 12$ V	$-I_{CB0}$	—	20	100	μA
przy $-U_{CB} = 12$ V, $t_{amb} = 343$ K (70°C)	$-I_{CB0}$	—	0,7	2,5	mA
Prąd zerowy emitera					
przy $-U_{EB} = 6$ V	$-I_{EB0}$	—	15	50	μA
Napięcie przebicia kolektor-baza					
przy $-I_C = 500$ μA, $I_E = 0$	$-U_{(BR)CB0}$	30	—	—	V
Napięcie przebicia kolektor-emiter					
przy $-I_C = 500$ μA, $R_{BE} = 0$	$-U_{(BR)CES}$	30	—	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza					
przy $-I_E = 100$ μA, $-I_C = 0$	$-U_{(BR)EB0}$	10	—	—	V

**Parametry dynamiczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość graniczna					
przy $-U_{CB} = 6$ V, $-I_C = 0,3$ A	$f_T$	100	180	—	kHz
Stosunek współczynników wzmocnienia prądowego dobranych par*					
przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 0,3$ A	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 3$ A	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

\* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określone w zamówieniu.

TRANZYSTOR ADP671

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298\text{ K}$ ( $25^\circ\text{C}$ )		min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmocnienia prądowego					
przy $-I_C = 0,3\text{ A}$ , $-U_{CE} = 6\text{ V}$	$h_{21E}$	30	—	200	—
przy $-I_C = 3\text{ A}$ , $-U_{CE} = 1\text{ V}$	$h_{21E}$	10	—	—	—
Prąd zerowy kolektora					
przy $-U_{CB} = 12\text{ V}$	$-I_{CB0}$	—	20	100	$\mu\text{A}$
przy $-U_{CB} = 12\text{ V}$ , $t_{amb} = 343\text{ K}$ ( $70^\circ\text{C}$ )	$-I_{CB0}$	—	0,7	2,5	$\text{mA}$
Prąd zerowy emitera					
przy $-U_{EB} = 6\text{ V}$	$-I_{EB0}$	—	15	50	$\mu\text{A}$
Napięcie przebicia kolektor-baza					
przy $-I_C = 500\ \mu\text{A}$ , $I_E = 0$	$-U_{(BR)CB0}$	20	—	—	$\text{V}$
Napięcie przebicia kolektor-emiter					
przy $-I_C = 500\ \mu\text{A}$ , $R_{BE} = 0$	$-U_{(BR)CES}$	20	—	—	$\text{V}$
Napięcie przebicia emiter-baza					
przy $-I_E = 100\ \mu\text{A}$ , $-I_C = 0$	$-U_{(BR)EB0}$	10	—	—	$\text{V}$

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298\text{ K}$ ( $25^\circ\text{C}$ )		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość graniczna					
przy $-U_{CB} = 6\text{ V}$ , $-I_C = 0,3\text{ A}$	$f_T$	100	180	—	$\text{kHz}$
Stosunek współczynników wzmocnienia prądowego*					
przy $-U_{CE} = 6\text{ V}$ , $-I_C = 0,3\text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1\text{ V}$ , $-I_C = 3\text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

TRANZYSTOR ADP672

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298\text{ K}$ ( $25^\circ\text{C}$ )		min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmocnienia prądowego					
przy $-I_C = 0,3\text{ A}$ , $-U_{CE} = 6\text{ V}$	$h_{21E}$	30	—	200	—
przy $-I_C = 3\text{ A}$ , $-U_{CE} = 1\text{ V}$	$h_{21E}$	10	—	—	—
Prąd zerowy kolektora					
przy $-U_{CB} = 12\text{ V}$	$-I_{CB0}$	—	20	100	$\mu\text{A}$
przy $-U_{CB} = 12\text{ V}$ , $t_{amb} = 343\text{ K}$ ( $70^\circ\text{C}$ )	$-I_{CB0}$	—	0,7	2,5	$\text{mA}$

Prąd zerowy emitera

przy  $-U_{EB} = 6\text{ V}$   $-I_{EB0}$  — 18 50  $\mu\text{A}$

Napięcie przebicia kolektor-baza

przy  $-I_C = 500\ \mu\text{A}$ ,  
 $I_E = 0$   $-U_{(BR)CB0}$  60 — —  $\text{V}$

Napięcie przebicia kolektor-emiter

przy  $-I_C = 500\ \mu\text{A}$ ,  
 $R_{BE} = 0$   $-U_{(BR)CES}$  60 — —  $\text{V}$

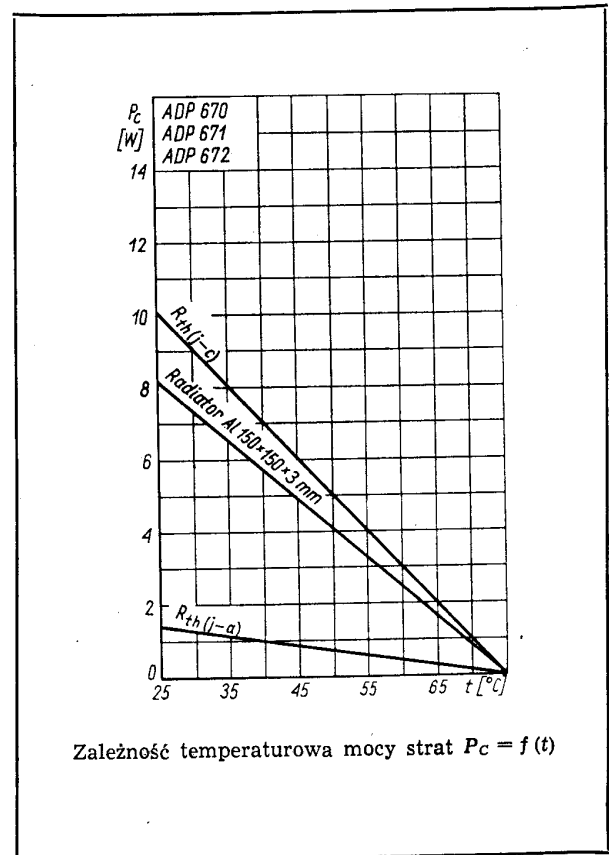
Napięcie przebicia emiter-baza

przy  $-I_E = 100\ \mu\text{A}$ ,  
 $-I_C = 0$   $-U_{(BR)EB0}$  10 — —  $\text{V}$

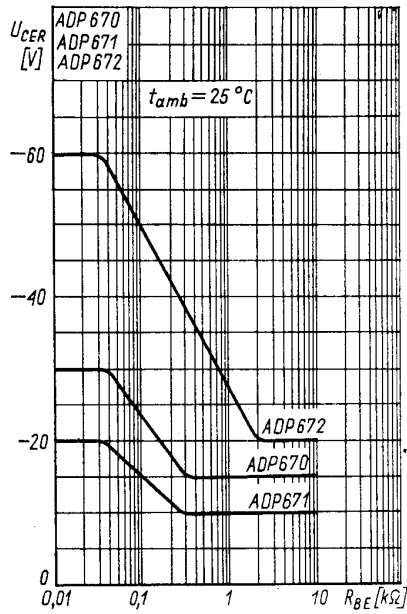
Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298\text{ K}$ ( $25^\circ\text{C}$ )		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość graniczna					
przy $-U_{CB} = 6\text{ V}$ , $-I_C = 0,3\text{ A}$	$f_T$	100	180	—	$\text{kHz}$
Stosunek współczynników wzmocnienia prądowego dobranych par*					
przy $-U_{CE} = 6\text{ V}$ , $-I_C = 0,3\text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1\text{ V}$ , $-I_C = 3\text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

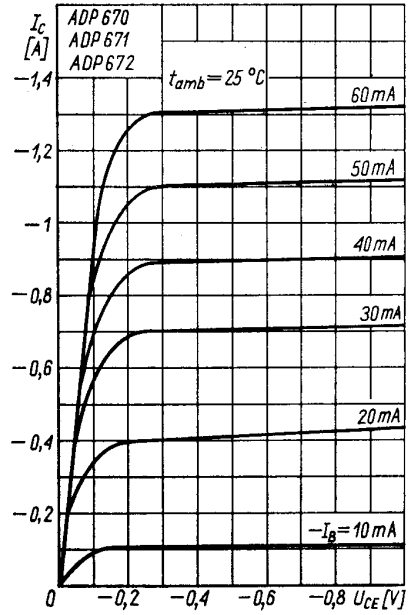
\* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określone w zamówieniu.



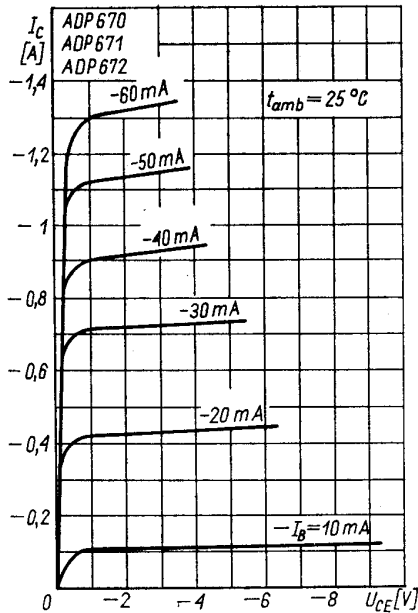
Zależność temperaturowa mocy strat  $P_c = f(t)$



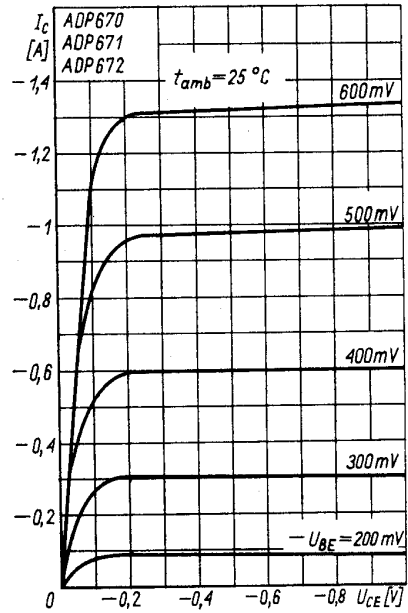
Zależność napięcia kolektor-emiter od rezystancji emiter-baza  $U_{CER} = f(R_{BE})$



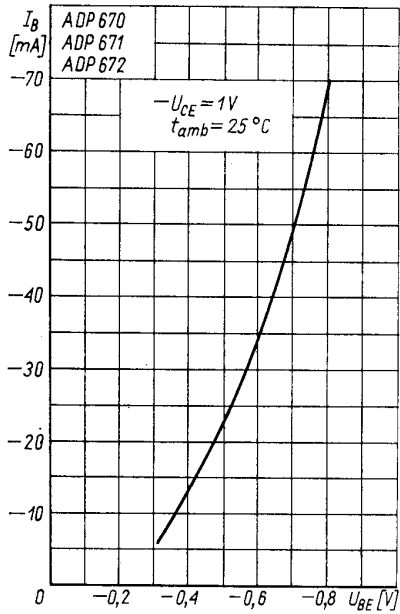
Charakterystyka wyjściowa  $I_C = f(U_{CE})$ ;  $I_B$  — parametr



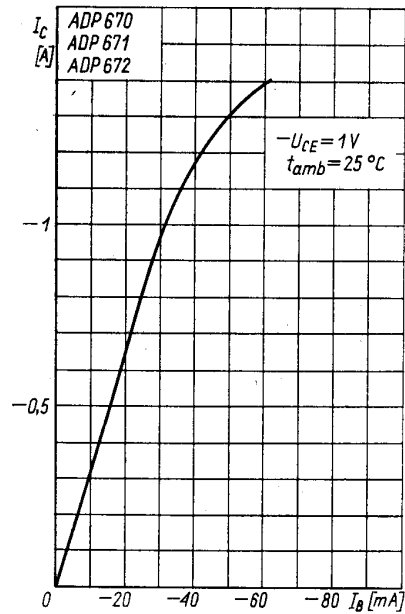
Charakterystyka wyjściowa  $I_C = f(U_{CE})$ ;  $I_B$  — parametr



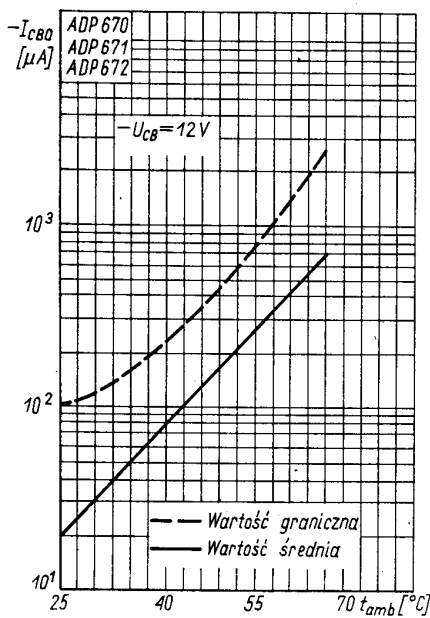
Charakterystyka wyjściowa  $I_C = f(U_{CE})$ ;  $U_{BE}$  — parametr



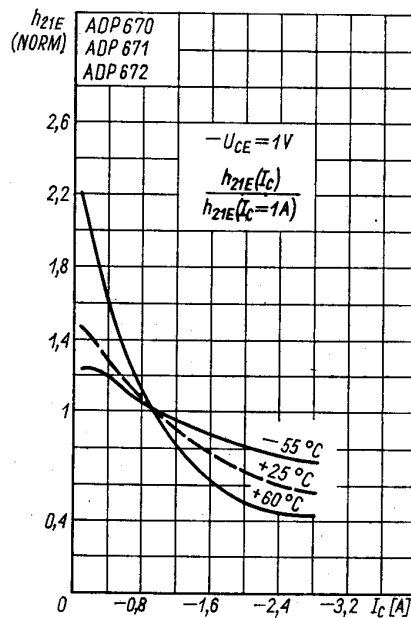
Charakterystyka wejściowa  $I_B = f(U_{BE})$ ;  $U_{CE}$  — parametr



Charakterystyka przejściowa  $I_C = f(I_B)$



Zależność temperaturowa prądu zerowego  $I_{CB0} = f(t_{amb})$



Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM  
PÓLPRZEWODNIKÓW „TEWA”  
ul. Komarowa 5  
02-675 Warszawa  
Telefon: 431431  
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU  
TELERRADIOTECHNICZNEGO  
ul. Nowogrodzka 50  
00-695 Warszawa  
Telefony: 289411, 286471  
Teleks: 813435



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

[LittleDiode.com](http://LittleDiode.com)

Looking forward to providing you with the best possible service.